This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT- 1994-201607

ACC-NO:

DERWENT- 199817

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Multi-stage, esp. two-stage, metal coating of substrates by arc discharge followed by cathodic evaporation using target contg. higher m.pt. component of a two phase target

and two-phase target

INVENTOR: MUENZ, W

PATENT-ASSIGNEE: MUENZ, W HAUZER TECHNO COATING EURO BV[HAUZN]

PRIORITY-DATA: 1992DE-4243915 (December 23, 1992)

PATENT-FAMILY:

P	PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE PAGES MAIN-IPC			
	S 2111691 3	March 16, 1998	N/A	000	C23C 014/02C23C 014/02C23C 014	
E	P 603486 A2	June 29, 1994	G	003	/02C23C 014/02C23C 014/02C23C	
	DE 4243915	June 30, 1994	N/A	003	014/02	
E	CP 603486 A3	December 6, 1995	N/A	000		
E	CP 603486 B1	February 4, 1998	G	004		
I G		March 12, 1998	N/A	000		

AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL AT BE CH DE ES DESIGNATED-

FR GB IE IT LI LU NL STATES:

No-SR.Pub; 2.Jnl.Ref; DE 3611492; EP 404973; CITED-

JP07113171 ; WO 9100374 DOCUMENTS:

APPLICATION-DATA:

PUB-NO			APPL-DESCRIPTOR APPL-NO			APPL-DATE			
	ES	2111691T3	N/A	199	3EP-	-0116882	October	19,	1993
	ES	2111691T3	Based on	EΡ	6034	486	N/A		
	ΕP	603486A2	N/A	199	3EP-	-0116882	October	19,	1993
	DE	4243915A1	N/A	199	2DE-	-4243915	December	23,	1992

EP 603486A3 N/A 1993EP-0116882 October 19, 1993
EP 603486B1 N/A 1993EP-0116882 October 19, 1993
DE59308111G N/A 1993EP-0508111 October 19, 1993
DE59308111G N/A 1993EP-0116882 October 19, 1993
DE59308111G Based on EP 603486 N/A

INT-CL C23C014/02, C23C014/06 , C23C014/14 , C23C014/24 ,

(IPC): C23C014/32 , C23C014/34

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 603486A

BASIC-ABSTRACT:

Multi-stage, esp. two-stage, coating of substrates by pretreatment in cathodic arc discharge metal vapour, partic. to achieve an anchoring zone, followed by cathodic evaporation. The target used during pretreatmen t is composed only of the higher m.pt. component of a two-phase target material used during further coating by cathodic evaporation.

The two-phase target material can be TiAl, ZrAl or CrAl, with the higher m.pt. component being Ti, Zr or Cr. Alternatively, a metal vapour of the higher m.pt. material is produced using an alloy of Ti, Zr and Cr contg. 2-50 at.%, pref. 15-30 at.% Ta, Nb or W. Partic. advantageous is the use of pure W targets in pretreatment of highspeed steel substrates, followed by plasma carbonisation, and then cathodic evaporation using TiAl, ZrAl or CrAl targets. Another process variation involves application of a 0.05-2 micron thick W coating to the substrate by arc discharge vaporisation or cathodic evaporation following pretreatment using a W target but prior to plasma carbonisation under vacuum and, finally, coating with TiAlN, ZrAlN or CrAlN. A WC target may be used for arc discharge vaporisation during the pretreatment stage, after which a 0.05-2 micron thick WC coating may be applied to the substrate. The various targets for pretreatment, namely Ti, Zr, Cr or their alloys (contg. Ta, Nb or W), and W or WC, are installed in the coating appts. together with the TiAl, ZrAl and CrAl targets.

USE/ADVANTAGE - As a coating in the mfr. of e.g. high-speed steel tools. Reduced deposition of lower m.pt. target material droplets on substrate surface during pretreatment.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 603486B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Multi-stage, esp. two-stage, coating of substrates by pretreatment in cathodic arc discharge metal vapour, partic. to achieve an anchoring

zone, followed by cathodic evaporation. The target used during pretreatmen t is composed only of the higher m.pt. component of a two-phase target material used during further coating by cathodic evaporation.

The two-phase target material can be TiAl, ZrAl or CrAl, with the higher m.pt. component being Ti, Zr or Cr. Alternatively, a metal vapour of the higher m.pt. material is produced using an alloy of Ti, Zr and Cr contg. 2-50 at.%, pref. 15-30 at.% $\underline{\text{Ta}}$, Nb or W. Partic. advantageous is the use of pure W $\underline{\text{targets}}$ in $\overline{\text{pre}}$ treatment of highspeed steel substrates, followed by plasma carbonisation, and then cathodic evaporation using TiAl, ZrAl or CrAl targets. Another process variation involves application of a $0.\overline{05-2}$ micron thick W coating to the substrate by arc discharge vaporisation or cathodic evaporation following pretreatment using a W target but prior to plasma carbonisation under vacuum and, finally, coating with TiAlN, ZrAlN or CrAlN. A WC target may be used for arc discharge vaporisation during the pretreatment stage, after which a 0.05-2micron thick WC coating may be applied to the substrate. The various $\underline{\text{targets}}$ for pretreatment, namely $\underline{\text{Ti,}}$ Zr, Cr or their alloys (contg. Ta, Nb or W), and W or WC, are installed in the coating appts. together with the TiAl, ZrAl and CrAl targets.

USE/ADVANTAGE - As a coating in the mfr. of e.g. high-speed steel tools. Reduced deposition of lower m.pt. target material droplets on substrate surface during pretreatment.

CHOSEN- Dwg.0/0 Dwg.0/0

DRAWING:

TITLE- MULTI STAGE TWO STAGE METAL COATING SUBSTRATE ARC

TERMS: DISCHARGE FOLLOW CATHODE EVAPORATION TARGET CONTAIN HIGH

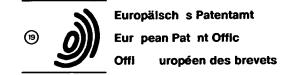
COMPONENT TWO PHASE TARGET TWO PHASE TARGET

DERWENT-CLASS: M13

CPI-CODES: M13-E05;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1994-092020





① Veröffentlichungsnummer: 0 603 486 A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93116882.7

② Anmeldetag: 19.10.93

(1) Int. Cl.5: C23C 14/02, C23C 14/06, C23C 14/14, C23C 14/32, C23C 14/34

Priorität: 23.12.92 DE 4243915

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.06.94 Patentblatt 94/26

 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL 71) Anmelder: HAUZER TECHNO COATING **EUROPE BV Groethofstraat 27** NL-5900 AE Venlo(NL)

2 Erfinder: Münz, Wolf-Dieter Gerard de Vlamingstraat 9 NL-5913 RV Venlo(NL)

(74) Vertreter: Finsterwald, Manfred, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. et al **Robert-Koch-Strasse 1** D-80538 München (DE)

(See Yerfahren zur mehrstufigen Beschichtung von Substraten.

(57) Es wird ein Verfahren zum mehrstufigen Beschichten von Substraten beschrieben, wobei zur Vorbehandlung des Substrats im Metalldampf des Bogenentladungsplasmas ein Target verwendet wird, das allein aus der höherschmelzenden Komponente eines zweiphasigen Targetmaterials besteht, während die Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung mit den zweiphasigen Targetmaterialien rfolgt.

10

15

25

30

35

Aus der europäischen Patentanmeldung 0 404 973 A1 ist ein V rfahren zur zweistufigen Beschichtung bekannt, bei dem das zu beschichtende Substrat, zum Beispiel Materialien zur Herstellung von Schneid- und Umformwerkzeugen, wie Schnellarbeitsstahl oder Harmetall, derart beschichtet wird, daß das Substrat zunächst im Dampf einer kathodischen Bogenentladung einer Vorbehandlung unterzogen und mit hochenergetischen Metallionen, zum Beispiel 1200 eV, des Schichtmaterials, wie Tilonen im Falle des TiN oder Zr+-lonen im Falle des ZrN etc., beschossen wird.

1

Auf diese Weise kann eine Verankerungszone g schaffen werden, auf der dann TiN, ZrN oder CrN mittels Kathodenzerstäubung abgeschieden wird. Dies gilt auch für ternäre Hartstoffschichten wie TiAIN, ZrAIN oder CrAIN.

Im Falle der zuletzt genannten Schichtmateriali n erweist es sich jedoch als Nachteil, daß bei V rwendung von zweiphasigen Targetmaterialien, wie zum Beispiel pulvermetallurgisch hergestellten TiAl-, ZrAl- oder CrAl-Targets, bei der genannten Vorbehandlung im Metalldampf der Bogenentladung typische Droplets aus dem niederschmelzend n Material, im vorliegenden Falle Al, auf der Substratoberfläche abgeschieden werden. Diese Droplets stören den homogenen Schichtaufbau und führen zu einer unerwünschten Aufrauhung der Schichtoberfläche.

Aufgabe der Erfindung ist es, dieses Problem zu beseitigen und die Dropletbildung zumindest weitestgehend zu reduzieren.

Gelöst wird diese Aufgabe nach der Erfindung im wesentlichen dadurch, daß zur Vorbehandlung im Metalldampf des Bogenentladungsplasmas ein Target verwendet wird, das allein aus der höherschmelzenden Komponente des zweiphasigen Targ tmaterials besteht, während die Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung mit den entsprechenden zweiphasigen Targetmaterialien erfolgt.

Wird beispielsweise als zweiphasiges Targetmat rlal TiAl, ZrAl oder CrAl verwendet, dann wird als Target in der Vorbehandlungsphase ein Target aus Ti, Zr oder Cr verwendet.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung wird zur Herstellung des Metalldampfes des höherschmelzenden Materials eine Legierung dieses Materials verwendet, das heißt im Falle der Verwendung von Ti, Zr oder Cr als höherschmelzendem Material wird eine Legierung mit Ta, Nb oder W verwendet.

Besonders vorteilhaft ist es im Hinblick auf eine weitere Verbesserung d r Haftfähigkeit, ein mit Wlonen vorbehand Ites Substrat vor d r B schichtung mit TiAl, ZrAl oder CrAl in r Plasma-Karbonisierung zu unterw rfen.

Ein weiter besonders vorteilhafte Variant der Erfindung besteht darin, daß das Substrat nach

d r Vorbehandlung mit hochenergetischen W-lonen des Bogenentladungsplasmas mittels iner weiteren Bogenentladungsverdampfung oder Kathodenzerstäubung mit einer Schicht aus Wolfram beschichtet wird und diese gebildete Schicht einer Plasma-Karbonisierung unterworfen wird, bevor eine Beschichtung TiAIN, ZrAIN oder CrAIN vorgenommen wird.

Weitere besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben, wobei sämtliche Merkmale, die in den Patentansprüchen angeführt sind, für die Erfindung wesentlich und zur Lösung der gestellten Aufgabe förderlich sind.

Für die Durchführung der zweistufigen Beschichtungsvorgänge gelten die in der europäischen Anmeldung 0 404 973 A1 beschriebenen Lehren in allgemeiner Weise, wobei die vorstehend erläuterten Modifizierungen besondere oder zusätzliche Maßnahmen darstellen.

Patentansprüche

 Verfahren zum mehrstufigen, insbesondere zweistufigen Beschichten von Substraten, wobei das Substrat im Dampf einer kathodischen Bogenentladung vorbehandelt wird, insbesondere um eine Verankerungszone zu schaffen, und anschließend eine Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung erfolgt, dadurch gekennzelchnet,

daß zur Vorbehandlung im Metalldampf des Bogenentladungsplasmas ein Target verwendet wird, das allein aus der höherschmelzenden Komponente des zweiphasigen Targetmaterials besteht, während die Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung mit den zweiphasigen Targetmaterialien erfolgt.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das aus der höherschmelzenden Komponente des zweiphasigen Targetmaterials bestehende Target aus Ti, Zr oder Cr besteht, und daß bei der Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung als zweiphasige Targetmaterialien TiAl, ZrAl oder CrAl verwendet werden.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzelchnet, daß zur Herstellung des Metalldampfes des höherschmelzenden Materials, zum Beispiel Ti, Zr oder Cr, ine Legierung dieser Materialien mit Ta, Nb oder W v rwendet wird.
 - Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Ant il von Ta, Nb od r W etwa 2 At%

2

50

55

5

15

20

25

30

35

bis 50 At% des Legierungsmaterials beträgt.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch a kennzeichn t. daß der Anteil an Ta, Nb oder W insbesondere bei etwa 15 At% bis 30 At% liegt.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vorbehandlung von Substratmaterialien aus Schnellarbeitsstahl zur Erzeugung der kathodischen Bogenentladung ein Target aus reinem Wolfram verwendet wird, während die Weiterbeschichtung mittels Kathodenzerstäubung mit TiAl-, ZrAl- oder CrAl-Targets erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das mit Wolfram-Ionen vorbehandelte Substrat vor der Beschichtung mit TiAl, ZrAl oder CrAl zur Schaffung einer Hartmetallschicht einer Plasma-Karbonisierung unterworfen wird.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat nach der Vorbehandlung mit hochenergetischen Wolfram-Ionen des Bogenentladungsplasmas mittels einer weiteren Bogenentladungsverdampfung oder einer Kathodenzerstäubung mit einer Schicht von etwa 0,05 µm bis etwa 2 µm Dicke aus Wolfram beschichtet wird und diese Schicht vor der Beschichtung mit TiAIN, ZrAIN oder CrAIN einer Plasma-Karbonisierung unterworfen wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß anstelle von Wolfram zur Vorbehandlung im Metalldampf einer Bogenentladung Targetmaterial aus Wolframcarbid (WC) verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

dadurch gekennzeichnet,

daß das Substrat nach der Vorbehandlung mit hochenergetischen W- und / oder C-lonen hergestellt in einer kathodischen Bogenentladung unter Verwendung eines WC-Targets mit einer WC-Schicht, ebenfalls mit einem WC-Target, mit einer Dick von etwa 0,05 µm bis etwa 2 um beschichtet wird.

11. V rfahren nach einem od r m hreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

daß die unt rschiedlichen Targets aus der Grupp Ti, Zr, Cr bzw. deren Legi rung mit Ta, Nb oder W bzw. die Targets aus W oder WC gemeinsam in einer Beschichtungsanlage mit den Targets aus TiAl, ZrAl, CrAl eingebaut sind.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Plasma-Karbonisierung in einer Prozeßfolge mit der Vorbehandlung der Substrate mit hochenergetischen Wolfram-lonen aus dem Metalldampf der Bogenentladung und die abschließende Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung mit TiAIN, ZrAIN und CrAIN in einer Vakuumprozeßfolge, das heißt in einer Vakuumanlage erfolgt.

55

50

3